

Центральное конструкторское
бюро уникального приборостроения
АН СССР, Москва

Поступило в Редакцию
9 октября 1990 г.

Письма в ЖТФ, том 17, вып. 1

12 января 1991 г.

01; 10

© 1991

РАДИАЦИОННАЯ ПОЛЯРИЗАЦИЯ РЕЛЯТИВИСТИЧЕСКИХ ПУЧКОВ В ИЗОГНУТОМ КРИСТАЛЛЕ

В.А. Арутюнов, Н.А. Кудряшов,
О.А. Мишин, В.М. Самсонов,
М.Н. Стриханов

Использование нетрадиционных методов для получения поляризованных пучков частиц высокой энергии в настоящее время весьма актуально [1]. Предложенная в [2] кинематическая теория радиационной поляризации при отклонении лептонных пучков с помощью изогнутого кристалла (ИК) [3] не учитывает радиационные потери энергии и многократное рассеяние в кристалле. Хорошо известно, однако, что в кристалле при высоких энергиях происходит значительное сокращение радиационной длины [4], что делает необходимым более тщательный учет влияния радиационных процессов на поляризационные эффекты.

В настоящей работе предложено кинетическое уравнение для функции распределения радиационных потерь энергии частиц в поле изогнутых плоскостей кристалла с учетом многократного рассеяния. Проведены численные расчеты для лептонных пучков ТэВ-й энергии.

Уравнение Больцмана для функции распределения частиц в поле изогнутых плоскостей кристалла имеет вид

$$\frac{\partial f_\xi(t, E, p_x, x)}{\partial t} + v_x \frac{\partial f_\xi}{\partial x} - \frac{\partial \mathcal{U}_{eff}}{\partial x} \frac{\partial f_\xi}{\partial p_x} = I_{st}^e + I_{st}^{rad}, \quad (1)$$

где t - время (глубина), E - энергия частиц; p_x , v_x , x - по-перечные (радиальные) импульс, скорость и координата; ξ - проекция вектора поляризации на ось изгиба кристалла, $\mathcal{U}_{eff}(x) = \mathcal{U}(x) - p_x v_x / R$ - эффективный потенциал ИК, $\mathcal{U}(x)$ - потенциал плоскостей прямого кристалла, R - радиус изгиба. Упругую часть интеграла столкновений разложим по передаваемым импульсам

$$I_{st}^e \approx \frac{1}{2} \frac{\partial^2}{\partial p_x^2} \left[g_x^2(x) f_\xi(t, E, p_x, x) \right], \quad \text{где } g_x^2(x) = \frac{1}{2} \nu p^2 \frac{\Delta \theta^2(x)}{\Delta S}; \quad \Delta \theta^2(x)/\Delta S -$$

средний квадрат угла многократного рассеяния, равный сумме вкладов от рассеяния на колеблющихся ядрах и электронах. Рассмотрим достаточно высокие энергии $\gamma \gg \gamma_c$, где γ – релятивистский фактор, $\gamma_c = M/E_c$, M – масса частицы, E_c – глубина потенциальной ямы изогнутых плоскостей; используется система единиц $\hbar = c = 1$. В этом случае угол отклонения частицы при излучении $\sim \gamma^{-1}$ значительно меньше характерных углов движения частицы в кристалле θ_c ($\theta_c = \sqrt{2E_c/\rho \sigma}$ – критический угол Линдхарда) и радиационная часть интеграла столкновений приближенно может быть представлена в виде

$$\begin{aligned} I_{st}^{rad} &= \int d\omega \left[\omega_{\xi \rightarrow \xi}(E+\omega, \omega, x) f_\xi(t, E+\omega, \frac{E+\omega}{E} p_x, x) + \right. \\ &+ \left. \dot{\omega}_{\xi \rightarrow \xi}(E+\omega, \omega, x) f_{-\xi}(t, E+\omega, \frac{E+\omega}{E} p_x, x) \right] \frac{(E+\omega)}{E} - \\ &- Q(E, x) = f_\xi(t, E, p_x, x), \end{aligned} \quad (2)$$

где $Q_\xi(E, x) = \int d\omega \cdot \omega_\xi(E, \omega, x)$; $\omega_\xi(E, \omega, x) = \omega_{\xi \rightarrow \xi} + \omega_{\xi \rightarrow -\xi}$ – суммарная вероятность излучения с заданным ξ , ω – частота.

В рамках квазиклассического операторного формализма [4] имеем следующие выражения для вероятностей излучения:

$$\begin{aligned} \omega_\xi(E, \omega, x) &= \frac{e^2}{2\pi\sqrt{3}\gamma^2} \left\{ \frac{z^2}{(1-z)} K_{2/3}(\alpha) + \int_{\alpha}^{\infty} K_{5/3}(y) dy - \right. \\ &\left. - \left(\vec{\xi} \left[\vec{\sigma}, \frac{\vec{\omega}}{\omega} \right] \right) z K_{1/3}(\alpha) \right\}; \\ \omega_{\xi \rightarrow -\xi}(E, \omega, x) &= \frac{e^2}{2\pi\sqrt{3}\gamma^2} \frac{z^2}{(1-z)} \left\{ K_{2/3}(\alpha) + \left(\vec{\xi} \left[\vec{\sigma}, \frac{\vec{\omega}}{\omega} \right] \right) K_{1/3}(\alpha) \right\}, \end{aligned} \quad (3)$$

где $K_y(y)$ – функция Макдональда, $z = \omega/E$, $\alpha = 2z/[3(1-z)]\chi(x)$, $\chi(z) = \gamma |dU/dx|/M^2$ – квантовый параметр излучения $\vec{\omega} = \vec{e}_x (-dU/dx)$ – классическое ускорение частицы.

Рассмотрение упрощается, если использовать условие „статистического равновесия“ Линдхарда. В этом случае для канализированных частиц, вводя поперечную энергию $E_\perp = p_x^2/2E + U_{eff}^{(x)}$, запишем „микроскопическую“ функцию распределения в следующем виде:

$$f(t, E, p_x, x) \frac{dp_x}{dx} = \mathcal{Y}(t, E, E_\perp) \frac{d}{T} \frac{dE_\perp}{\sigma_x}, \quad (4)$$

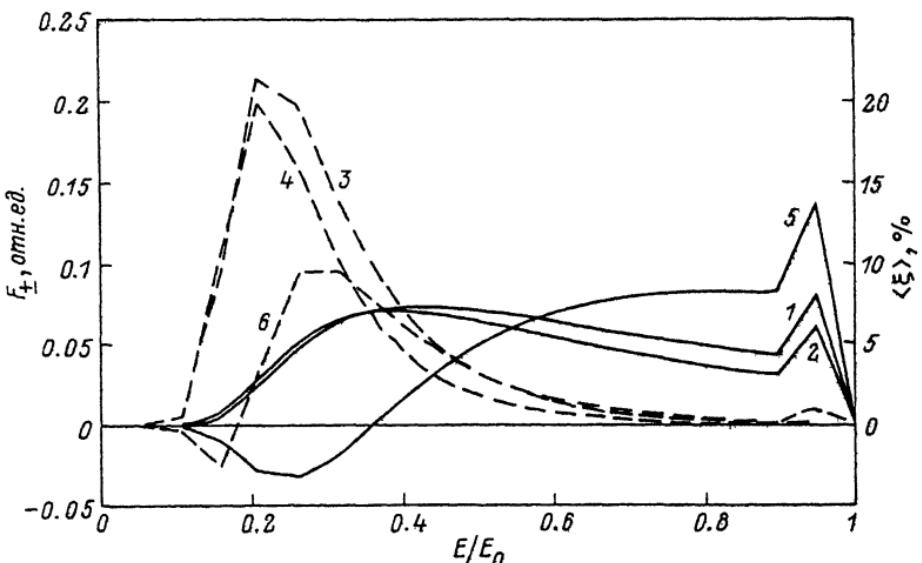


Рис. 1. Распределения радиационных потерь энергии (кривые 1–4) и распределения степени поляризации (кривые 5, 6) для электронного пучка с энергией 0.5 ТэВ в ИК кремния на различных глубинах: $S_1=0.5$ мм (кривые 1, 2, 5), $S_2=1.5$ мм (кривые 3, 4, 6)

где $\Psi(t, E, E_\perp)$ – функция распределения по поперечным энергиям, d – межплоскостное расстояние, T – период колебаний в канале.

После несложных преобразований получаем следующее кинетическое уравнение:

$$\frac{\partial \Psi_\xi(t, E, E_\perp)}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial E_\perp} \left[T D \frac{\partial}{\partial E_\perp} \left(\frac{\Psi_\xi}{T} \right) \right] + \int d\omega \frac{1}{T} \phi \frac{\partial x}{\partial x} \times \\ \times \frac{(E+\omega)}{E} \left[w_{\xi \rightarrow \xi}(E+\omega, \omega, x) \Psi_\xi(E+\omega, E'_\perp) + w_{\xi \rightarrow \xi}(E+\omega, \omega, x) \times \right. \\ \left. \times \Psi_\xi(t, E+\omega, E'_\perp) - \langle Q_\xi(E, E_\perp) \rangle \Psi_\xi(t, E, E_\perp) \right], \quad (5)$$

где D – коэффициент диффузии вследствие многократного рассеяния [5], $E'_\perp = E_\perp(E+\omega)/E - \chi_{eff}(x)\omega/E$, скобки $\langle \dots \rangle$ означают усреднение по периоду колебаний в канале.

При малых значениях квантового параметра излучения $\chi(x) \ll 1$ эффективные частоты излучения, согласно (3), малы: $\omega_{eff}/E \ll 1$. В этом случае, выполняя необходимые разложения, из (5) непосредственно получаем известное уравнение „диффузационной модели“ канализования [5]. Для неканализированных частиц в уравнении (1) следует перейти к переменной $E_{2\perp} = P_x^2/2E + U(x)$, где $E_{2\perp} = P_x^2/2E + U(x)$ – „поперечная энергия в прямом кристалле“ [6]. Полученную систему уравнений необходимо решить с соответствующими

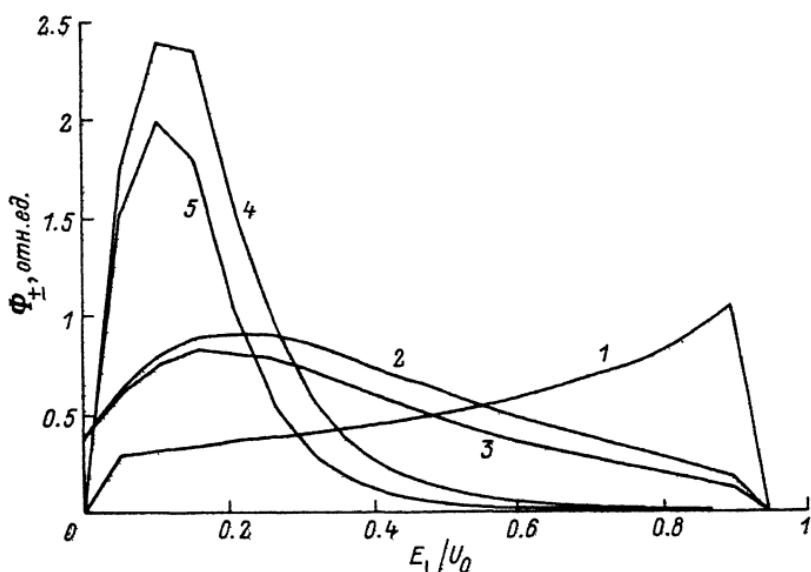


Рис. 2. Эволюция распределений по поперечным энергиям для пучка частиц в кристалле с теми же параметрами, что на рис. 1. Кривая 1 - начальное распределение; кривые 2, 3 - распределения на глубине $s_1 = 0.5$ мм; кривые 4, 5 - распределения на глубине $s_2 = 1.5$ мм; $U_0 \equiv \max U(x)$.

условиями сшивки функций распределения и потоков канализированных и неканализированных частиц [7].

На рис. 1 представлены результаты численных расчетов, согласно уравнению (5), распределений радиационных потерь энергии $F_z(t, E) = \int dE_1 \varphi_z(t, E, E_1)$, соответствующим различным значениям $\xi = \pm 1$ (кривые 1-4) и распределений степени поляризации по энергиям частиц пучка $\langle \xi \rangle = \frac{F_+ - F_-}{F_+ + F_-}$ (кривые 5, 6) для электронного пучка с энергией 0.5 ТэВ на различных глубинах в ИК кремния: $s_1 = 0.5$ мм (кривые 1, 2, 5), $s_2 = 1.5$ мм (кривые 3, 4, 6). Частицы движутся в потенциале (100)-плоскостей ИК кремния с радиусом изгиба $R/R_c = 8$, где $R_c = \gamma M / |vU_{\max}|$ - критический радиус Цыганова. Начальное распределение выбиралось в виде:

$$f_{in}(E_1) = T(E_1) / \int_0^{E_c} T(E_1) dE_1, \quad \text{что соответствует нормированному}$$

распределению при влете в кристалл прямоугольного пучка с угловой шириной $4\theta_0 = 2\theta_c$ (см. например, формулу (10) из работы [6]).

На рис. 2 изображена эволюция распределения частиц по поперечным энергиям с глубиной $\Phi_\pm(t, E_1) = \int dE \varphi_\pm(t, E, E_1)$ для того же пучка. Видно, что "широкое" начальное распределение (кривая 1) несколько сужается (кривые 2-5).

Список литературы

- [1] Тернов И.М. // ЭЧАЯ. 1986. Т. 15. В. 5. С. 884-928.
- [2] Михалев В.Л., Рзаев В.А. // ЖЭТФ. 1982. Т. 82. В. 6. С. 1713-1724.
- [3] Сумбаев О.И. // Препринт ЛИЯФ № 1201. 1986.
- [4] Байер В.Н., Катков В.М., Страховенко В.М. Электромагнитные процессы при высокой энергии в ориентированных монокристаллах. Новосибирск: Наука, 1989. 396 с.
- [5] Белошицкий В.В., Кумахов М.А. // ДАН СССР. 1973. Т. 221. В. 4. С. 846-849.
- [6] Кудряшов Н.А., Петровский С.В., Стриханов М.Н. // ЖТФ. 1989. Т. 59. В. 4. С. 68-73.
- [7] Белошицкий В.В., Старостин В.А. // Письма в ЖТФ. 1988. Т. 14. В. 8. С. 722-726.

Московский
инженерно-физический
институт

Поступило в Редакцию
14 февраля 1990 г.

Письма в ЖТФ, том 17, вып. 1
03; 05.3

12 января 1991 г.

© 1991

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ НА КРИСТАЛЛИЗАЦИЮ
ЖИДКИХ УПОРЯДОЧЕННЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ СТРУКТУР

Е.Н. Ведмединко, М.В. Курик,
И.Н. Кувичка

Значительную часть молекулярной массы многих биологических жидкостей человеческого организма составляют сложные липидные и липид-белковые комплексы. Полярные частицы липидов сильно взаимодействуют с водой и могут смешиваться с ней в любых соотношениях. Возникающие смеси образуют многообразные упорядоченные фазы с периодической структурой.

Большинство биожидкостей организма человека кристаллизуется при высушивании. Известны различные виды кристаллов, образующихся при кристаллизации ротовой жидкости человека в норме и при ряде патологий [1, 2]. Форма этих структур, а также морфо-кинетический механизм кристаллизации существенно зависят от изменений в биохимическом составе, нарушений обмена с окружающей средой, фазовой структуры биологической жидкости и ее межмолекулярного упорядочения. Справедливость указанных заключений под-